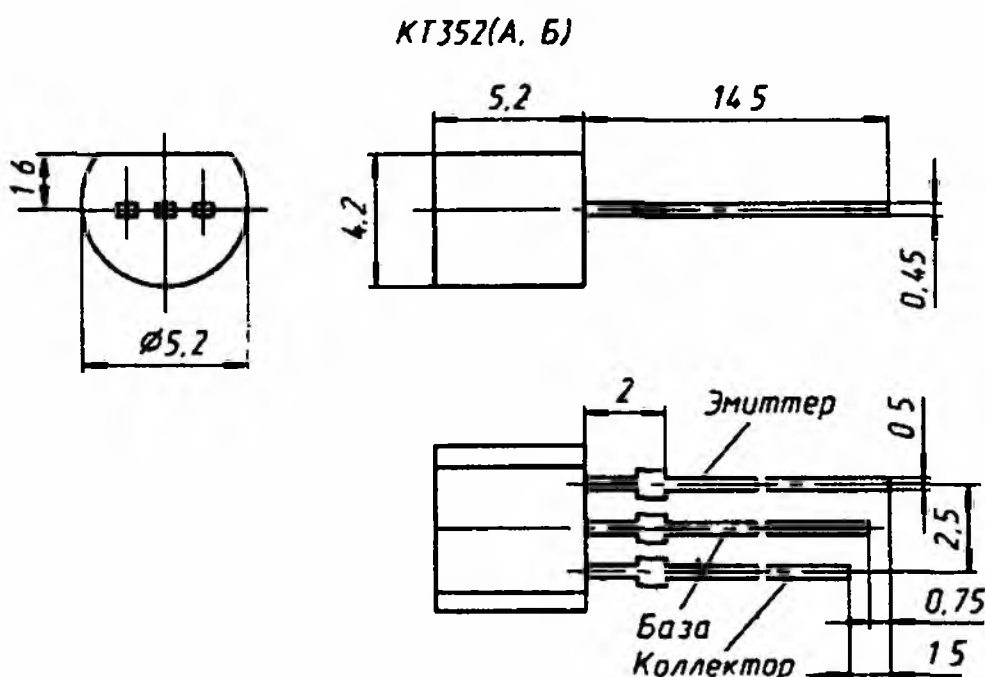


## КТ352А, КТ352Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры  $p-n-p$  усилительные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. На корпусе наносится условная маркировка двумя цветными точками: КТ352А — зеленой и розовой, КТ352Б — зеленой и желтой.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Изготовитель — завод полупроводниковых приборов, г. Рига.



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КБ} = 1$  В,  $I_3 = 200$  мА:

$T = +25$  °С:

КТ352А ..... 25...65\*...120

КТ352Б ..... 70...115\*...300

$T = -40$  °С, не менее ..... 0,3 значения при  $T = +25$  °С

$T = +85$  °С ..... От 0,9 до 2 значений при  $T = +25$  °С

Граничная частота коэффициента передачи

тока при  $U_{КБ} = 5$  В,  $I_3 = 10$  мА, не менее ..... 200 МГц

типичное значение ..... 450\* МГц

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 200$ мА, $I_b = 20$ мА для КТ352А, $I_b = 3$ мА для КТ352Б, не более .....	0,6 В
типичное значение .....	0,37* В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 200$ мА, $I_b = 20$ мА для КТ352А, $I_b = 3$ мА для КТ352Б, не более .....	1,1 В
типичное значение .....	0,81* В
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 10$ В, не более:	
$T = +25$ °С .....	1 мкА
$T = +85$ °С .....	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4$ В, не более .....	10 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5$ В, не более .....	15 пФ
типичное значение .....	9,5* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 1$ В, не более .....	30 пФ
типичное значение .....	20* пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база .....	20 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{бэ} \leq 10$ кОм .....	15 В
Постоянное напряжение эмиттер—база .....	5 В
Импульсный ток коллектора при $t_n \leq 1$ мкс, $Q \geq 10$ .....	200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>1</sup> :	
при $T \leq +30$ °С .....	300 мВт
при $T = +85$ °С .....	162,5 мВт
Тепловое сопротивление переход—среда .....	0,4 °С/мВт
Температура р-п перехода .....	+150 °С
Температура окружающей среды .....	-40...+85 °С

<sup>1</sup> В диапазоне температур +30...+85 °С допустимое значение рассеиваемой мощности снижается линейно.

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм.

Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до корпуса 5 мм при температуре не выше +250 °С и длительности не более 10 с. Температура корпуса при пайке не должна превышать +150 °С.